

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ CuO

*A.A. Самохвалов, Н.Н. Лошкарёва, Ю.П. Сухоруков,
В.А. Груверман, Б.А. Гижевский, Н.М. Чеботаев*

В спектрах поглощения монокристаллов антиферромагнитного полупроводника CuO в области 0,08 – 1,50 эВ обнаружены особенности, природа которых обсуждена в связи с известными спектрами ВТСП на основе CuO и спектрами 3d-антиферромагнитных диэлектриков.

В свойствах высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на основе CuO существенную роль играют связи Cu–O–Cu. С целью изучения характера этих связей исследованы спектры отражения и поглощения монокристаллов CuO в области 0,08 – 1,50 эВ на автоматизированном спектрометре ИКС-21. Как известно^{1, 2}, в ВТСП в этом диапазоне наблюдается полоса поглощения и световой проводимости (0,3 – 0,5 эВ), которая может быть связана с электронными возбуждениями, ответственными за сверхпроводимость^{2 – 4}. Оптические свойства CuO исследовались лишь в одной работе⁵, в которой приведен спектр отражения поликристаллического образца CuO, в области энергий, меньших 0,08 эВ (фононный спектр).

Монокристаллы CuO размером 8 × 3 × 2 мм выращивались из раствора в расплаве. Типичные значения параметров моноклинной кристаллической решетки CuO $a = 4,77 \text{ \AA}$, $b = 3,88 \text{ \AA}$, $c = 5,00 \text{ \AA}$. Угол между осями a и c $99,5^\circ$. По результатам рассеяния нейтронов⁶ CuO является антиферромагнетиком ($T_N = 230 \text{ K}$) со сложной магнитной структурой. Антиферромагнитная связь в цепочках Cu–O–Cu образует угол 146° , между ближайшими соседними ионами Cu связь ферромагнитна. Кристаллы полировались вдоль плоскости (110), в которой лежит ось c .

Электросопротивление монокристаллов CuO при комнатной температуре вдоль оси c составляет $10^2 \text{ Ом} \cdot \text{см}$ и к 100 K возрастает до 10^{12} Ом см . Анизотропия сопротивления при 293 K $\rho_{\perp c} / \rho_{\parallel c} = 1,7$. Энергия активации ϵ_a вблизи 293 K равна для разных образцов $0,12 – 0,16 \text{ эВ}$. Около 190 K зависимость $\lg \rho(1/T)$ имеет отчетливый излом, при этом ϵ_a при охлаждении возрастает до $0,28 – 0,30 \text{ эВ}$ и остается неизменной до 100 K . Все образцы CuO имеют дырочную проводимость и низкую подвижность носителей заряда ($< 0,1 \text{ см}^2 / \text{В} \cdot \text{с}$).

Спектр отражения (вставка к рис. 1) типичен для полупроводника в области между межзонным и решеточным поглощением. В спектрах поглощения (рис. 1) монокристалла CuO наблюдается полоса поглощения при $0,220 \pm 0,004 \text{ эВ}$. На эту полосу накладываются фононные повторения с энергией $\sim 0,02 \text{ эВ}$ ($\sim 160 \text{ см}^{-1}$), соответствующей низкоэнергетической фононной полосе, наблюдавшейся в спектрах CuO, La_2CuO_4 ⁵ и $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ ⁷ и испытывающей в последнем соединении смягчение при переходе в сверхпроводящее состояние. Полоса поглощения при $0,086 \pm 0,003 \text{ эВ}$, фононные повторения которой наблюдаются, разделяется со своим первым повторением лишь в призованном свете.

($E \perp c$ или $E \parallel c$), и, возможно, связана с внутрицентровым переходом в ионе Cu (без переноса заряда).

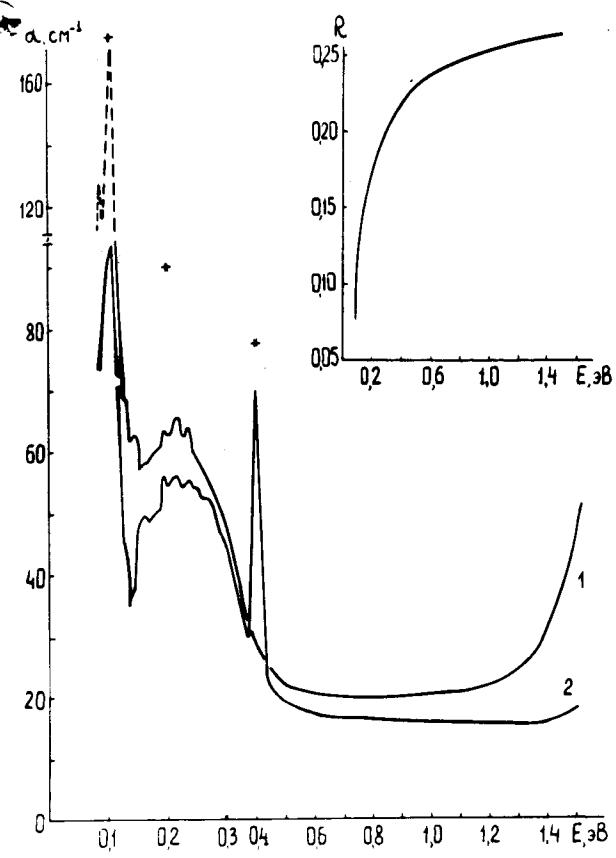


Рис. 1. Спектры поглощения моно-
кристалла CuO при 1 – 293 К, 2 –
80 К. Пунктир – в поляризованном
свете $E \parallel c$. На вставке – спектр от-
ражения

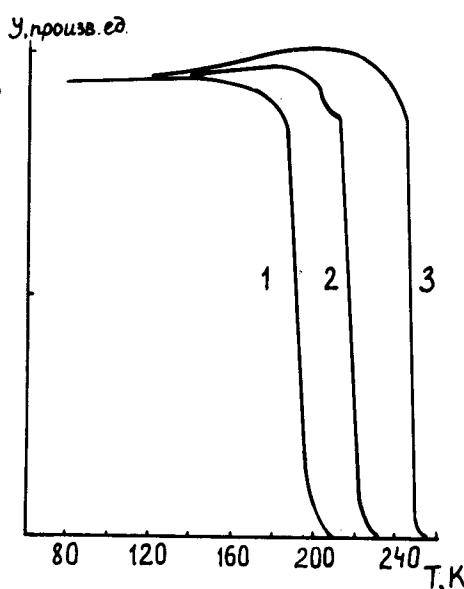


Рис. 2. Температурная зависимость интенсивности по-
лосы при 0,40 эВ в магнитном поле $H = 1$ кЭ. 1 – $H = 0,2$, 2 – $H \perp c$, 3 – $H \parallel c$

В области полосы при 0,22 эВ обнаружен значительный линейный дихроизм для поляризации света вдоль и перпендикулярно оси c , достигающий $(\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp})/\alpha \approx 30\%$, что указывает на электродипольный характер перехода. По виду спектра и имея в виду зависимость $\rho(T)$, можно заключить, что порог примесного поглощения составляет $\sim 0,14$ эВ. Эта величина близка к энергии активации электросопротивления. Температурная зависимость пропускания при 0,14 эВ следует зависимости $\rho(T)$ с изломом около ~ 190 К. Характер анизотропии поглощения ($\alpha_{\parallel} > \alpha_{\perp}$) вблизи полосы совпадает с характером анизотропии электропроводности. Расчет световой проводимости σ показал полосу σ , совпадающую с полосой поглощения при 0,22 эВ. Таким образом видна корреляция оптических и электрических свойств, свидетельствующая о связи полосы при 0,22 эВ с проводимостью. Вследствие сильной гибридизации d^9 -состояний Cu^{2+} с кислородной валентной зоной, проводимость с малой подвижностью носителей заряда и наличие соответствующего оптического перехода являются, по-видимому, следствием переноса заряда $d^9 - d^{10}L$ (где L – дырка на кислороде)⁸. Энергия переноса заряда, оцененная из фотоэмиссионных данных⁹ для $(La_{0,9}Sr_{0,1})_2CuO_{4-y}$ ($T_c = 34$ К) и $YBa_2Cu_3O_{6,6,9}$ ($T_c = 90$ К) составляет 0,4 эВ и 0,5 эВ, соответственно, что совпадает с энергиями наблюдавшихся оптических переходов в

этих соединениях. Таким образом, в CuO как и в ВТСП, имеются носители заряда с малой подвижностью¹.

В спектре поглощения CuO ниже T_N резко возникает узкий пик при $0,40 \pm 0,01$ эВ с полушириной $0,04$ эВ. Положение линии в зависимости от температуры в пределах погрешности не меняется. Температура появления пика зависит от приложенного магнитного поля (рис. 2). Интенсивность пика зависит от способа охлаждения и интервала времени между измерениями. Например, когда после измерений температурной зависимости интенсивности пика при нагреве образца (в поле или без него), образец снова охлаждался от температуры чуть выше T_N , то пик уменьшался или не наблюдался совсем. Для повторного наблюдения пика после нагрева образца до комнатной температуры требуется время порядка суток. Известно¹⁰, что в оптических спектрах $3d$ -антиферромагнитных диэлектриков в области магнитного упорядочения появляются новые линии — экситон-магнонного или фонон-магнонного поглощения. Для того, чтобы предположить, что полоса при $0,40$ эВ является одной из двух указанных выше, необходимо, чтобы энергия магнона в CuO составляла не менее ~ 1500 см⁻¹. В спектре рамановского рассеяния в La₂CuO₄¹¹ обнаружена полоса двухмагнонного рассеяния при ~ 3000 см⁻¹ ($0,37$ эВ) с полушириной ~ 1000 см⁻¹ ($0,12$ эВ), связанная с двухразмерными спиновыми флюктуациями выше T_N , в частности при 300 К ($T_N = 240$ К — температура Нееля трехмерного антиферромагнитного порядка). В CuO также возможен низкоразмерный магнетизм, однако, появление пика в CuO только ниже $T_N = 230$ К, вероятно, с этим не связано. Резкая температурная зависимость интенсивности пика, долговременная релаксация интенсивности могут указывать на образование магнитного полярона около кислородной вакансии, т. е. локального ферромагнитного образования в антиферромагнитной трехмерной матрице¹². Взаимодействие между спинами кислородной вакансии и ионов Си в связи Си—О—Си приводит к параллельному выстраиванию спинов ионов меди. Магнитное поле сравнительно небольшой напряженности (до 1 кЭ) способствует этому процессу, сдвигая температуру появления пика в область более высоких температур. Влияние поля существенно анизотропно. Так в магнитном поле параллельном оси с полоса поглощения существует вплоть до $T = 250$ К, при которой остался лишь ближний антиферромагнитный порядок. Энергетическая разница между полосами $0,22$ эВ и $0,40$ эВ — $0,18$ эВ совпадает с добавкой к энергии активации электросопротивления, появляющейся при магнитном упорядочении.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о близком соответствии оптических свойств CuO и оксидных ВТСП на основе CuO. В последних сильное друдевское поглощение коллективизированными носителями заряда не всегда позволяет выявить оптическим методом особенности, четко наблюдаемые в CuO. Таким образом CuO является важным объектом для выяснения природы ВТСП и роли антиферромагнетизма.

Литература

1. Самохвалов А.А., Чуботаев Н.М., Лошаков Н.И. и др. Письма в ЖЭТФ, 1988, **47**, 338.
2. Kamaras K., Porter C.D., Doss M.G. et al. Phys. Rev. Lett., 1987, **59**, 919.
3. Wachter P., Degiorgi L. Sol. St. Comm., 1988, **66**, 211.
4. Geserich H.P., Scheiber G., Creek J. et al. Europhys. Lett., 1988, **6** (3), 277.
5. Degiorgi L., Kaldus E., Wachter P. Physica C, 1988, **153** — **155**, 657.
6. Forsyth J.B., Brown P.J., Wanklyn B.M. J. Phys. C: Sol. St. Phys., 1988, **21**, 2917.
7. Bonn D.A., O'Reilly A.H., Greedan J.E. et al. Phys. Rev. B, 1988, **37**, 1574.
8. Zaanen J., Sawatzky G.A., Allen J.W. Phys. Rev. Lett., 1985, **55**, 418.
9. Fujimori A., Takayama-Miromachi E., Uchida Y. et al. Phys. Rev. B, 1987, **35**, 8814.
10. Еременко В.В., Беляева А.И. УФН, 1969, **98**, 27.

11. Lyons K.B., Fleury P.A., Remeika J. et al. Phys. Rev., 1988, 37, 2353.

12. Нагаев Э.Л. Письма в ЖЭТФ, 1967, 6, 484.

Институт физики металлов

Уральское отделение Академии наук СССР

Поступила в редакцию

16 марта 1989 г.